

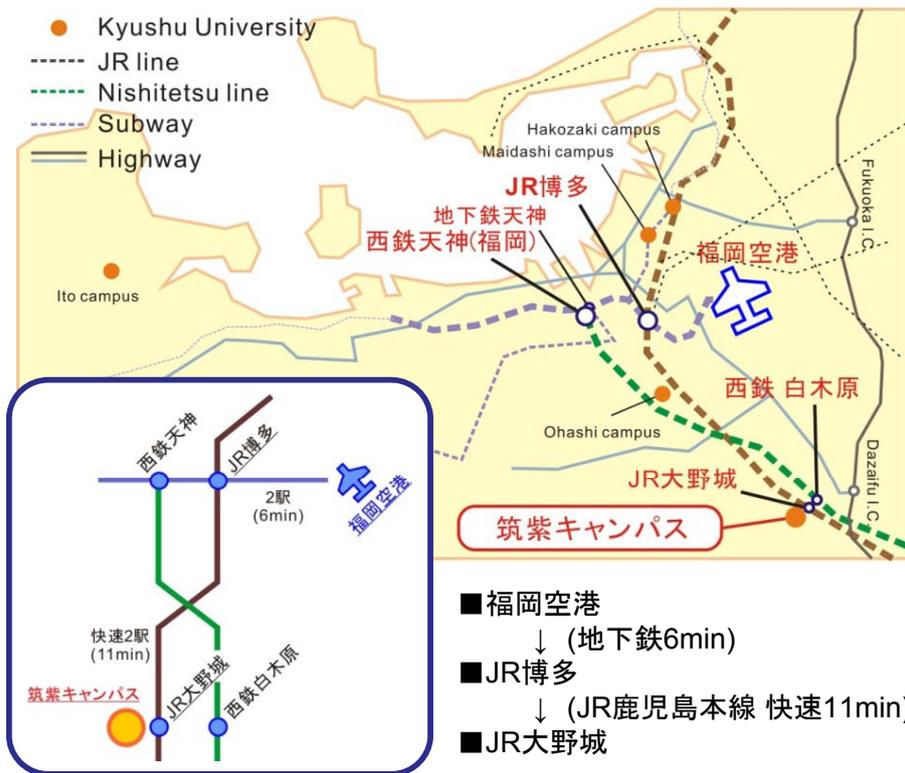
# 第3回 窒化物半導体結晶成長講演会

2011年 6月17日(金)~18日(土)

九州大学 筑紫キャンパス、総合研究棟(C-CUBE) 筑紫ホール



九大C-CUBE



**開催の趣旨** 窒化物半導体分野においては、紫外発光素子、パワーエレクトロニクス、太陽電池など次々と新しい応用が開拓されています。窒化物半導体の結晶成長技術に関しては平成22年7月に第3回III族窒化物結晶成長国際シンポジウム(ISGN-3)がフランス モンペリエにて開催され、専門の研究者を一堂に介してこの分野の議論を深めました。本講演会では、窒化物半導体の結晶成長科学を理解することを目的に若手研究者の育成を目指しています。

## 【招待講演者】

### ■ 基調講演 ■

・吉川明彦(千葉大学)  
「窒化物半導体超薄膜量子井戸構造/短周期超格子の形成とSMART太陽電池への展開」

### ■ チュートリアル ■

・藤岡 洋(東京大学)  
「低温PXD成長技術を用いた高In組成InGaNの素子応用」  
・福山博之(東北大学)  
「サファイア窒化法の熱力学と窒化機構およびその展開(仮題)」  
・播磨 弘(京都工芸繊維大学)  
「GaN系窒化物半導体のラマン散乱分光法による評価」  
・桑野範之(九州大学)  
「結晶の皺(しわ)を鑑(み)る。  
— 電子顕微鏡による欠陥の解析 —」

### ■ 招待講演 ■

・村上 尚、富樫理恵、熊谷義直、瀨瀬明伯(東京農工大学)  
「In系窒化物半導体のMOVPE、HVPE成長」  
・西川 敦、寺井慶和、藤原康文(大阪大学)  
「OMVPE法により作製したEu添加GaNの発光特性及び赤色発光ダイオードへの応用」  
・赤坂哲也、小林康之、嘉数 誠(NTT物性基礎研究所)  
「表面過飽和度制御によるGaNステップフリー面の形成」

### ■ 奨励賞 受賞講演 ■

・藤川紗千恵、平山秀樹(理研)  
「AlGaIn系深紫外LEDの開発(仮題)」  
・小島一信、山口敦史\*, 船戸 充, 川上養一, 野田進(京都大学、\*金沢工業大学)  
「非極性面窒化物半導体の光学特性に関する理論的検討」

ポスター発表(ショートプレゼンテーションを含む)を受け付けています。詳細は下記URLをご覧ください。

アブストラクト切: 5月27日(金)

参加費 一般: 会員¥2000、非会員¥5000  
学生: 会員 無料、非会員¥1000  
意見交換会 一般: ¥2000、学生¥1000

(主催) 日本結晶成長学会ナノ構造・エピタキシャル成長分科会  
(共催) 応用物理学会 結晶工学分科会、九州大学 応用力学研究所 全国共同利用研究集会  
(後援) 日本学術振興会「ワイドギャップ半導体 光・電子デバイス」第162委員会

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jacg/japanese/nanoepi/>